

令和7(2025)年3月修了 材料系材料コース修士論文発表会(CS-2)

開催日:2025年2月7日(金)

会場:すずかけ台キャンパス 大学会館2階集会室1

時間	発表者	審査員(主査)	審査員	論文題目	コース
9:00 ~ 9:19	井芹 航陽	神谷 利夫	片瀬 貴義 真島 豊	コンビナトリアルスパッタによる高性能ガスセンサに向けたアモルファス In-Ga-Zn-O 薄膜の組成最適化	材料
9:20 ~ 9:39	南島 悠人	神谷 利夫	片瀬 貴義 大場 史康	層状半導体Bi ₂ O ₃ S ₂ の熱電・欠陥特性に関する第一原理計算	材料
9:40 ~ 9:59	落合 将寛	片瀬 貴義	神谷 利夫 川路 均	歪みを制御したSrTiO ₃ 薄膜への水素ドーピングと熱電特性	材料
10:00 ~ 10:19	富永 和	片瀬 貴義	神谷 利夫 舟窪 浩	共スパッタ法を用いたAlScN/IGZO強誘電体トランジスタの作製	材料
10:20 ~ 10:45	CHOI Sangjin	片瀬 貴義	神谷 利夫 真島 豊 舟窪 浩 川路 均	水素置換BaTiO ₃ 薄膜の低熱伝導率と熱電変換特性	材料
休憩					
10:55 ~ 11:14	田中 晴	真島 豊	神谷 利夫 伊澤 誠一郎	平衡・非平衡半導体ナノプレートトランジスタ特性におけるエネルギー準位の解明	材料
11:15 ~ 11:34	矢澤 卓	真島 豊	神谷 利夫 伊澤 誠一郎	IGZOナノワイヤーナノギャップ水素ガスセンサーの高機能化	材料
11:35 ~ 11:54	河村 和哉	松田 晃史	舟窪 浩 片瀬 貴義	ニッケル酸ランタン薄膜のエピタキシャル成長および還元による酸素欠損型構造の作製	材料
11:55 ~ 12:14	北村 裕大	松田 晃史	松下 伸広 岸 哲生	導電性ポリアニリン薄膜表面への熱ナノインプリントによるナノ形状制御	材料
12:15 ~ 12:34	QIAO YUCHI	松田 晃史	松下 伸広 片瀬 貴義	紫外線照射による亜酸化銅エピタキシャル薄膜の表面構造変化および導電性制御	材料
昼食休憩					
13:20 ~ 13:39	長澤 遼河	平松 秀典	片瀬 貴義 大場 史康	スピネル型カルコゲナイドの合成と電子輸送特性評価	材料
13:40 ~ 13:59	福永 朋孝	平松 秀典	片瀬 貴義 大場 史康	ワイドギャップp型酸化物半導体の探索	材料
14:00 ~ 14:19	山下 耕平	平松 秀典	片瀬 貴義 大場 史康	ワイドギャップMgSe薄膜へのキャリアドーピングと電子構造	材料
14:20 ~ 14:39	包 安	平松 秀典	片瀬 貴義 大場 史康	ペロブスカイト型LaWN ₃ のヘテロエピタキシャル成長	材料
14:40 ~ 14:59	井口 洸	原 亨和	鎌田 慶吾 石川 理史	担持金属触媒による5-ヒドロキシメチルフルフラールからの2,5-ビスアミノメチルフランのワンポット合成	材料
休憩					
15:10 ~ 15:29	中村 匠	鎌田 慶吾	原 亨和 石川 理史	OMS-1超微粒子のイオン交換能を利用した酸化触媒開発	材料
15:30 ~ 15:49	牧澤 昌史	鎌田 慶吾	原 亨和 石川 理史	Ruドーブ六方晶ペロブスカイト触媒を用いたスルフィドの酸素酸化	材料
15:50 ~ 16:09	川口 竜一	大場 史康	平松 秀典 片瀬 貴義	ダイヤモンド及びシリコン表面の安定性とバンド位置の理論的検討	材料
16:10 ~ 16:29	喜屋武 采莉	大場 史康	平松 秀典 片瀬 貴義	スピネル型硫化物における点欠陥の第一原理計算による検討	材料
16:30 ~ 16:49	高松 新	大場 史康	神谷 利夫 平松 秀典	グラフニューラルネットワークを用いた無機化合物の電子・光学特性予測	材料
16:50 ~ 17:15	長藤 瑛哉	大場 史康	鎌田 慶吾 神谷 利夫 平松 秀典 片瀬 貴義	第一原理計算による La ₂ SnO ₂ S ₃ のキャリア生成・補償機構の解明	材料